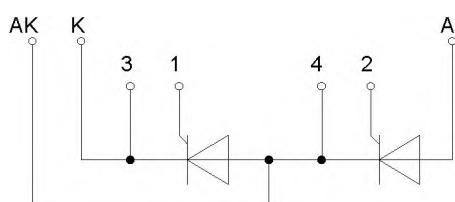
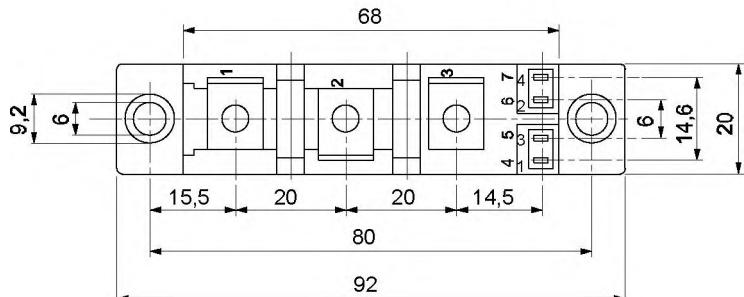
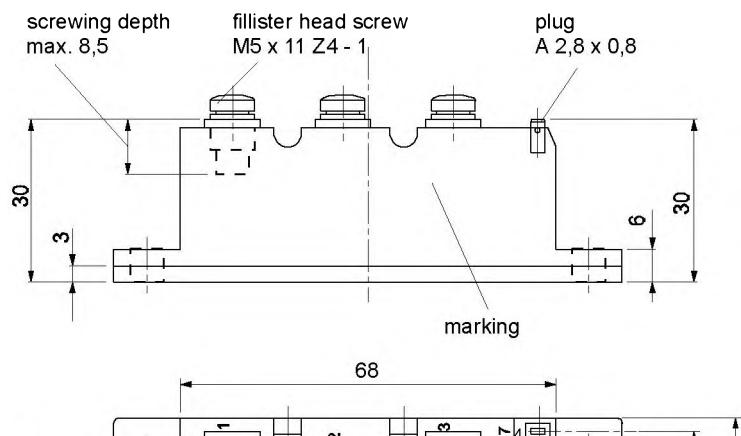


European Power-
Semiconductor and
Electronic Company

Marketing Information TT 25 N



TT 25 N

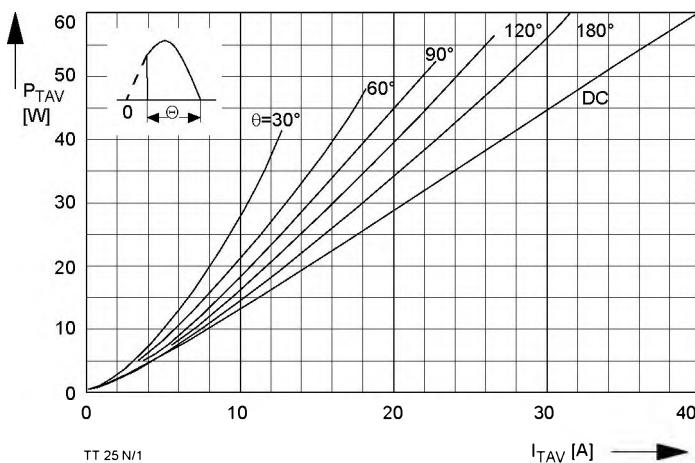


Bild / Fig. 1

Durchlaßverlustleistung je Zweig / On-state power loss per arm
 $P_{TAV} = f(I_{TAV})$
Parameter: Stromflußwinkel / current conduction angle θ

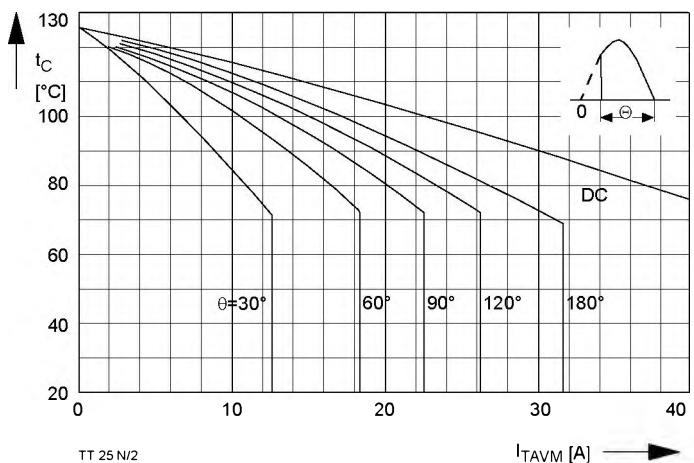


Bild / Fig. 2

Höchstzulässige Gehäusetemperatur / Maximum allowable case temperature
 $t_C = f(I_{TAVM})$
Strombelastung je Zweig / current load per arm
Parameter: Stromflußwinkel / current conduction angle θ

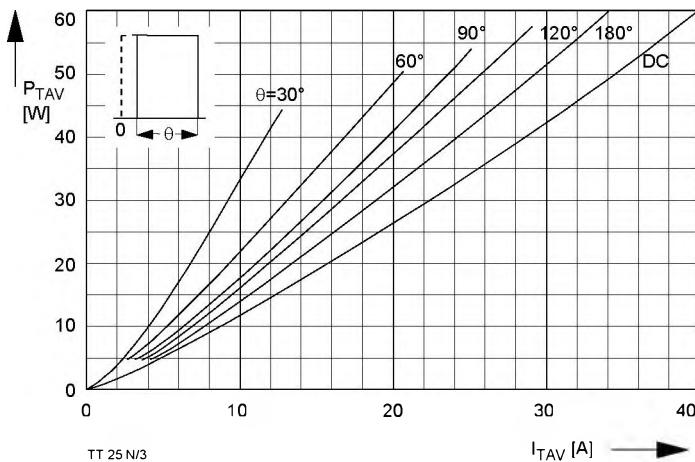


Bild / Fig. 3

Durchlaßverlustleistung je Zweig / On-state power loss per arm
 $P_{TAV} = f(I_{TAV})$
Parameter: Stromflußwinkel / current conduction angle θ

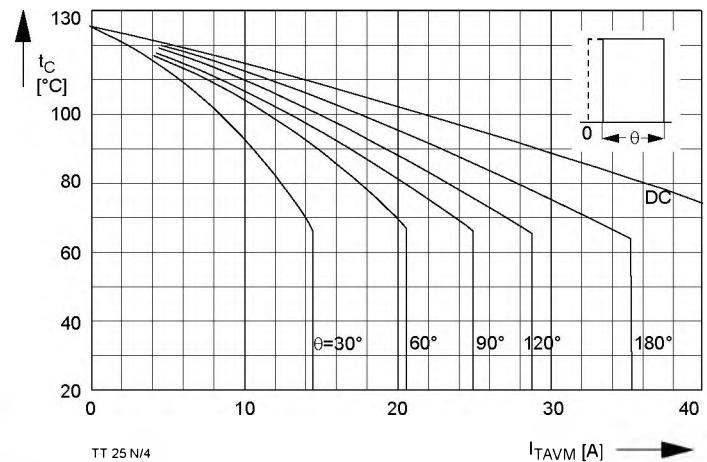


Bild / Fig. 4

Höchstzulässige Gehäusetemperatur / Maximum allowable case temperature
 $t_C = f(I_{TAVM})$
Strombelastung je Zweig / current load per arm
Parameter: Stromflußwinkel / current conduction angle θ

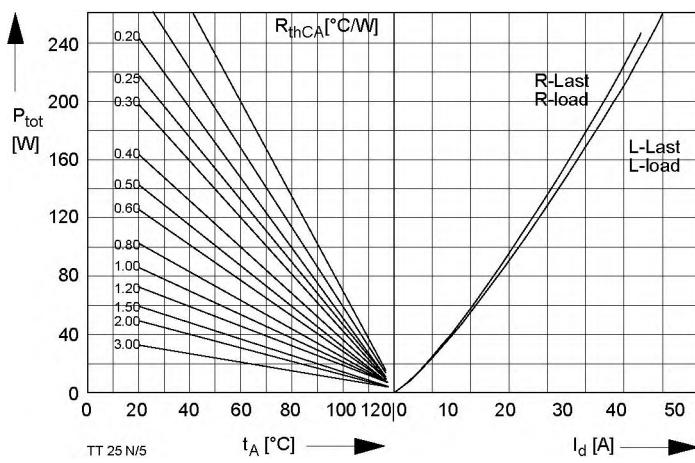


Bild / Fig. 5

B2 - Zweiplus-Brückenschaltung / Two-pulse bridge circuit
Höchstzulässiger Ausgangsstrom / Maximum rated output current I_d
Gesamtverlustleist. der Schaltung / total power dissip. of the circuit P_{tot}
Parameter: Wärmewiderstand zwischen Gehäuse und Umgebung / thermal resistance case to ambient R_{thCA}

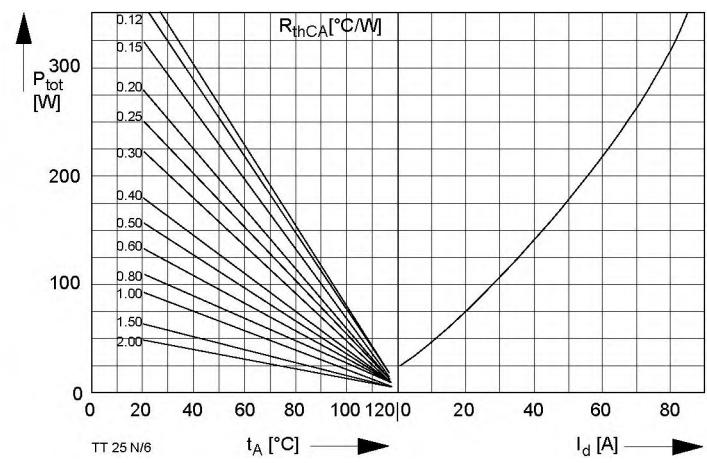


Bild / Fig. 6

B6 - Sechspuls-Brückenschaltung / Six-pulse bridge circuit
Höchstzulässiger Ausgangsstrom / Maximum rated output current I_d
Gesamtverlustleist. der Schaltung / total power dissip. of the circuit P_{tot}
Parameter: Wärmewiderstand zwischen Gehäuse und Umgebung / thermal resistance case to ambient R_{thCA}

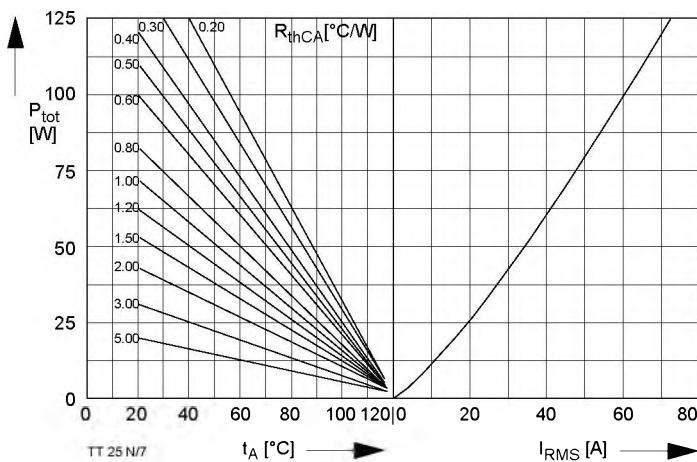


Bild / Fig. 7
W1C - Einphasen-Wechselwegschaltung / Single-phase inverse parallel circuit
Höchstzulässiger Effektivstrom / Maximum rated RMS current I_{RMS}
Gesamtverlustleist. der Schaltung / Total power dissip. of the circuit P_{tot}
Parameter: Wärmewiderstand zwischen Gehäuse und Umgebung/
thermal resistance case to ambient R_{thCA}

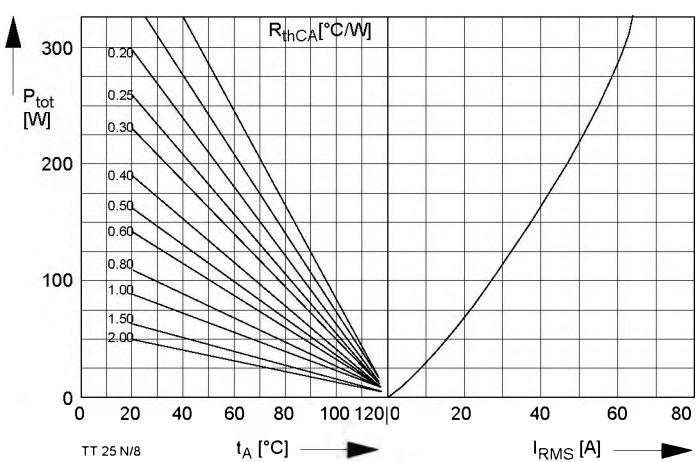


Bild / Fig. 8
W3C - Dreiphasen-Wechselwegschaltung / Three-phase inverse parallel circuit
Höchstzulässiger Effektivstrom je Phase / Maximum rated RMS current per phase I_{RMS}
Gesamtverlustleist. der Schaltung / Total power dissip. of the circuit P_{tot}
Parameter: Wärmewiderstand zwischen Gehäuse und Umgebung/
thermal resistance case to ambient R_{thCA}

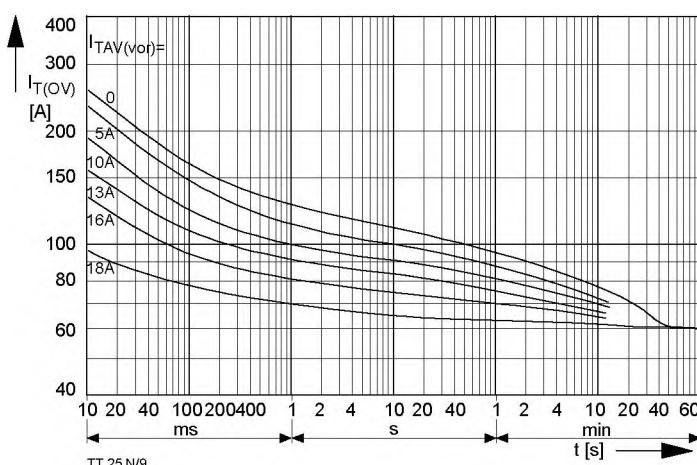


Bild / Fig. 9
B2 - Zweiplus - Brückenschaltung / Two - pulse bridge circuit
Überstrom je Zweig $I_T(\text{OV})$ bei Luftselbstkühlung, $t_A=45^\circ\text{C}$,
Kühlkörper KP0,33S /
Overload on-state current per arm $I_T(\text{OV})$ at natural cooling, $t_A=45^\circ\text{C}$,
heatsink type KP 0,33S
Parameter: Vorlaststrom je Zweig / pre-load current per arm $I_{\text{TAV(vor)}}$

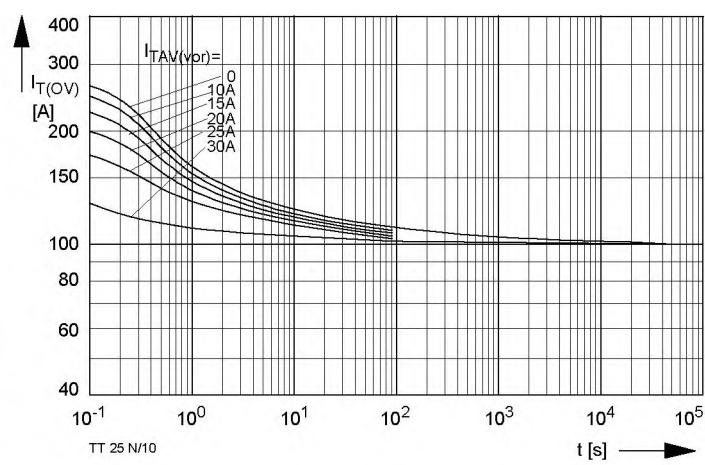


Bild / Fig. 10
B2 - Zweiplus - Brückenschaltung / Two - pulse bridge circuit
Überstrom je Zweig $I_T(\text{OV})$ bei verstärkter Luftkühlung, $t_A=35^\circ\text{C}$, $V_L=90\text{V}/\text{s}$,
Kühlkörper KP0,33S /
Overload on-state current per arm $I_T(\text{OV})$ at forced cooling, $t_A=35^\circ\text{C}$, $V_L=90\text{V}/\text{s}$,
heatsink type KP 0,33S.
Parameter: Vorlaststrom je Zweig / pre-load current per arm $I_{\text{TAV(vor)}}$

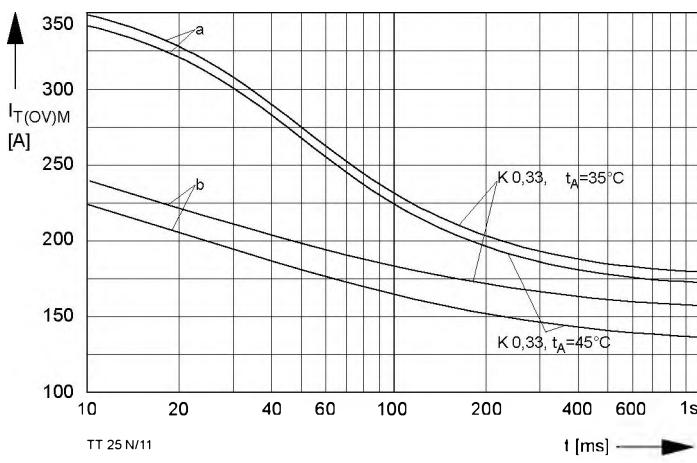


Bild / Fig. 11
Grenzstrom je Zweig $I_T(\text{OV})_M$ bei Luftselbstkühlung, $t_A=45^\circ\text{C}$ und verstärkter
Luftkühlung, $t_A=35^\circ\text{C}$, Kühlkörper KP 0,33S, $v_{RM} = 0,8 V_{RRM}$.
Limiting overload on state current per arm $I_T(\text{OV})_M$ at natural ($t_A=45^\circ\text{C}$) and
forced ($t_A=35^\circ\text{C}$) cooling, heatsink type KP 0,33S, $v_{RM}=0,8 V_{RRM}$.
a - Belastung nach Leerlauf / current surge under no-load conditions
b - Belastung nach Betrieb mit Dauergrenzstrom I_{TAVM} /
Current surge occurs during operation at limiting mean on- state current
rating I_{TAVM}

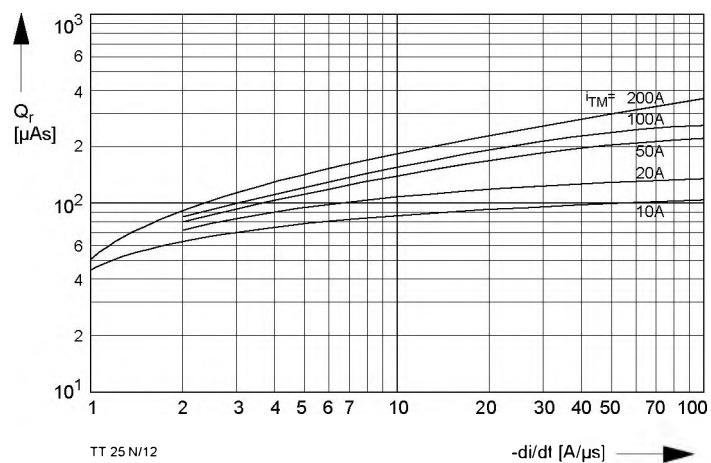


Bild / Fig. 12
Sperrverzögerungsladung / Recovery charge $Q_r = f(-di/dt)$
 $t_{vj} = t_{vjmax}$, $V_R \leq 0,5 V_{RRM}$, $V_{RM} = 0,8 V_{RRM}$
Parameter: Durchlaßstrom / On-state current i_{TM}

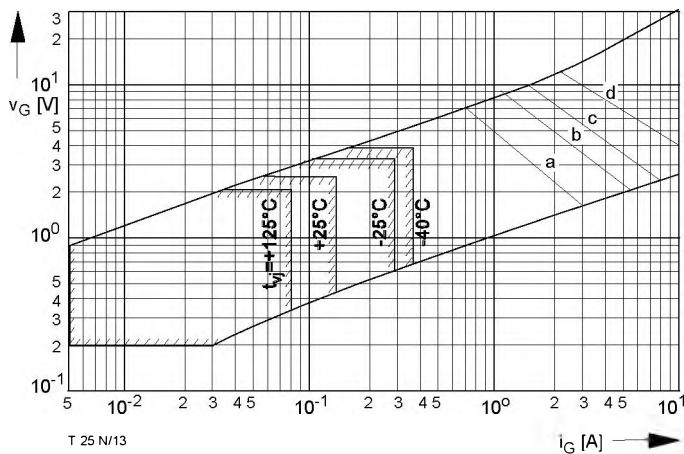


Bild / Fig. 13

Steuercharakteristik mit Zündbereichen / Gate characteristic with triggering areas, $v_G = f(i_G)$, $v_D = 6 \text{ V}$

Parameter: a b c d

Steuerimpulsdauer / Pulse duration t_g [ms] 10 1 0,5 0,1

Höchstzulässige Spitzesteuerleistung/ Maximum allowable peak gate power [W] 5 10 15 30

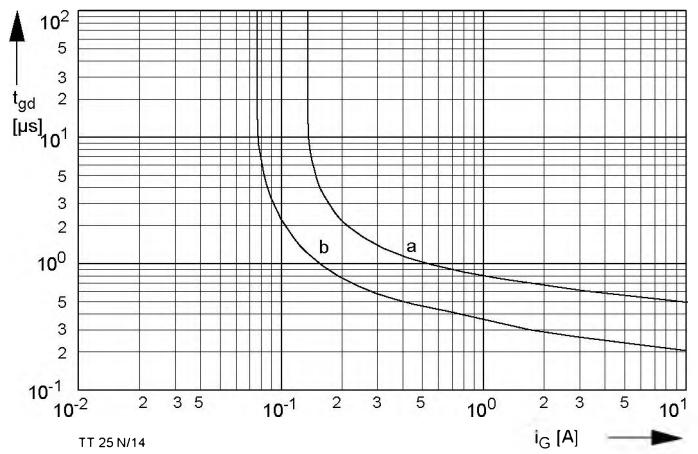


Bild / Fig. 14

Zündverzug / Gate controlled delay time $t_{gd} = f(i_G)$ $t_{vj} = 25^\circ\text{C}$, $di_G/dt = i_{GM}/1\mu\text{s}$

a - äußerster Verlauf / limiting characteristic

b - typischer Verlauf / typical characteristic

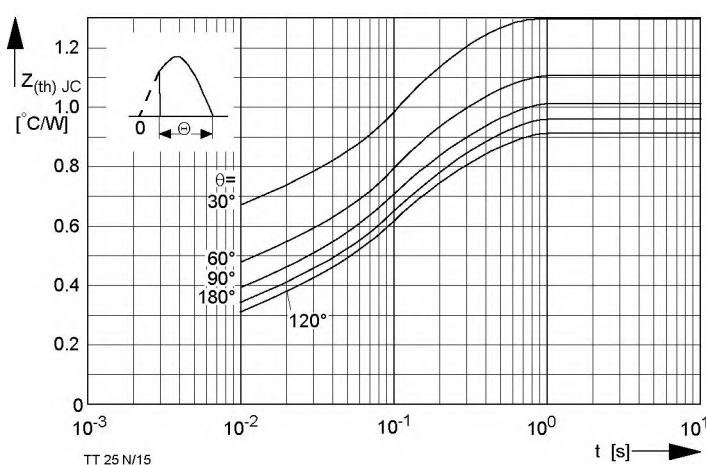


Bild / Fig. 15

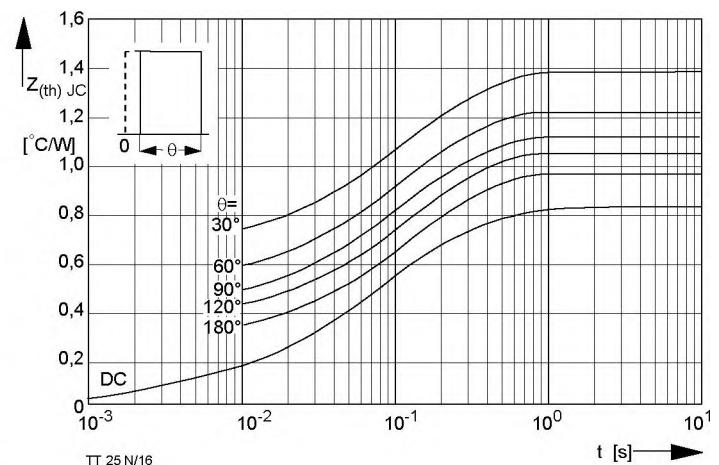
Transienter innerer Wärmewiderstand je Zweig / Transient thermal impedance per arm $Z_{(th)JC} = f(t)$ Parameter: Stromflußwinkel / current conduction angle θ 

Bild / Fig. 16

Transienter innerer Wärmewiderstand je Zweig / Transient thermal impedance per arm $Z_{(th)JC} = f(t)$ Parameter: Stromflußwinkel / current conduction angle θ Analytische Elemente des transienten Wärmewiderstandes Z_{thJC} pro Zweig für DC
Analytical elements of transient thermal impedance Z_{thJC} per arm for DC

Pos. n	1	2	3	4	5	6	7
$R_{thn} [\text{°C/W}]$	0,0517	0,111	0,162	0,511			
$\tau_n [\text{s}]$	0,00153	0,00968	0,0501	0,173			

Analytische Funktion / Analytical function:

$$Z_{thJC} = \sum_{n=1}^{n_{max}} R_{thn} (1 - e^{-\frac{t}{\tau_n}})$$

TT 25 N, TD 25 N, DT 25 N

Elektrische Eigenschaften		Electrical properties			
Höchstzulässige Werte		Maximum rated values			
Periodische Vorwärts- und Rückwärts-Spitzensperrspannung	repetitive peak forward off-state and reverse voltages	$t_{vj} = -40^{\circ}\text{C} \dots t_{vj\max}$	V_{DRM}, V_{RRM}	800 1200 1400 1600	V
Vorwärts-Stoßspitzenperrspannung	non-repetitive peak forward off-state voltage	$t_{vj} = -40^{\circ}\text{C} \dots t_{vj\max}$	V_{DSM}	800 1200 1400 1600	V
Rückwärts-Stoßspitzenperrspannung	non-repetitive peak reverse voltage	$t_{vj} = +25^{\circ}\text{C} \dots t_{vj\max}$	V_{RSM}	900 1300 1500 1700	V
Durchlaßstrom-Grenzeffektivwert	RMS on-state current		I_{TRMSM}	50	A
Dauergrenzstrom	average on-state current	$t_c = 85^{\circ}\text{C}$ $t_c = 68^{\circ}\text{C}$	I_{TAVM}	25 32	A
Stoßstrom-Grenzwert	surge current	$t_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, t_p = 10 \text{ ms}$ $t_{vj} = t_{vj\max}, t_p = 10 \text{ ms}$	I_{TSM}	580 510	A
Grenzlastintegral	I^2t -value	$t_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, t_p = 10 \text{ ms}$ $t_{vj} = t_{vj\max}, t_p = 10 \text{ ms}$	I^2t	1680 A ² s 1300 A ² s	
Kritische Stromsteilheit	critical rate of rise of on-state current	DIN IEC 747-6, $f = 50 \text{ Hz}, v_L = 8 \text{ V}$ (di_T/dt) _{cr}		100 A/ μs	
Kritische Spannungssteilheit	critical rate of rise of off-state voltage	$I_{GM} = 0.6 \text{ A}, di_G/dt = 0.6 \text{ A/\mu\text{s}}$ $t_{vj} = t_{vj\max}, V_D = 0.67 V_{DRM}$ 6.Kennbuchstabe/6th letter F	$(dv_D/dt)_{cr}$	1000 V/ μs	
<i>Charakteristische Werte</i>		<i>Characteristic values</i>			
Durchlaßspannung	on-state voltage	$t_{vj} = t_{vj\max}, i_T = 80 \text{ A}$	V_T	max.2,0	V
Schleusenspannung	threshold voltage	$t_{vj} = t_{vj\max}$	$V_{T(TO)}$	1,05	V
Ersatzwiderstand	slope resistance	$t_{vj} = t_{vj\max}$	r_T	11	m Ω
Zündstrom	gate trigger current	$t_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, v_D = 6 \text{ V}$	I_{GT}	max. 150	mA
Zündspannung	gate trigger voltage	$t_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, v_D = 6 \text{ V}$	V_{GT}	max.2,5	V
Nicht zündender Steuerstrom	gate non-trigger current	$t_{vj} = t_{vj\max}, v_D = 6 \text{ V}$	I_{GD}	max. 5	mA
Nicht zündende Steuerspannung	gate non-trigger voltage	$t_{vj} = t_{vj\max}, v_D = 0.5 V_{DRM}$	V_{GD}	max.2,5	mA
Haltestrom	holding current	$t_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, v_D = 6 \text{ V}, R_A = 10 \Omega$	I_H	max. 200	mA
Einraststrom	latching current	$t_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, v_D = 6 \text{ V}, R_{GK} > 20 \Omega$	I_L	max. 600	mA
Vorwärts- und Rückwärts-Sperrstrom	forward off-state and reverse currents	$i_{GM} = 0.6 \text{ A}, di_G/dt = 0.6 \text{ A/\mu\text{s}, } t_g = 20 \text{ } \mu\text{s}$	i_D, i_R	max. 8	mA
Zündverzug	gate controlled delay time	$v_D = V_{DRM}, v_R = V_{RRM}$ DIN IEC 747-6, $t_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $i_{GM} = 0.6 \text{ A}, di_G/dt = 0.6 \text{ A/\mu\text{s}}$	t_{gd}	max.1,2	μs
Freiwerdezeit	circuit commutated turn-off time	$t_{vj} = t_{vj\max}, i_{TM} = I_{TAVM}$ $v_{RM} = 100 \text{ V}, v_{DM} = 0.67 V_{DRM}$ $dv_D/dt = 20 \text{ V/\mu\text{s}, } -di_T/dt = 10 \text{ A/\mu\text{s}}$ 5.Kennbuchstabe/5th letter O	t_q	typ.80	μs
Isolations-Prüfspannung	insulation test voltage	RMS, $f = 50 \text{ Hz}, 1 \text{ min.}$ RMS, $f = 50 \text{ Hz}, 1 \text{ sec.}$	V_{ISOL}	3 kV ¹⁾ 3,6 kV ¹⁾	
<i>Thermische Eigenschaften</i>		<i>Thermal properties</i>			
Innerer Wärmewiderstand	thermal resistance, junction to case	pro Modul/per module, $\Theta = 100^{\circ}\text{C/W}$ pro Zweig/per arm, $\Theta = 180^{\circ} \sin \frac{\pi}{n}$ pro Modul/per module, DC pro Zweig/per arm, DC pro Modul/per module pro Zweig/per arm	R_{thJC}	max.0,46 °C/W max.0,92 °C/W max.0,42 °C/W max.0,84 °C/W max.0,1 °C/W max.0,2 °C/W	
Übergangs-Wärmewiderstand	thermal resistance, case to heatsink		R_{thCK}		
Höchstzul. Sperrsichttemperatur	max. junction temperature		$t_{vj\max}$	125	°C
Betriebstemperatur	operating temperature		$t_c op$	-40...+125	°C
Lagertemperatur	storage temperature		t_{stg}	-40...+125	°C
<i>Mechanische Eigenschaften</i>		<i>Mechanical properties</i>			
Gehäuse, siehe Seite	case, see page				
Si-Elemente mit Lötkontakt, glaspassiviert	Si-pellet with soldered contact, glass-passivated				
Innere Isolation	internal insulation				Al_2O_3
Anzugsdrehmoment für mechanische Befestigung	mounting torque	Toleranz/tolerance +/- 15%	M1	4	Nm
Anzugsdrehmoment für elektrische Anschlüsse	terminal connection torque	Toleranz/tolerance +5%/-10%	M2	4	Nm
Gewicht	weight		G	typ.125	g
Kriechstrecke	creepage distance			12,5	mm
Schwingfestigkeit	vibration resistance	$f = 50 \text{ Hz}$		50	m/s^2
Kühlkörper / heatsinks: KP 0,5 S; KP 0,41 S; KP 0,35 S; KP 0,33 S					
¹⁾ nur gültig für 4.Kennbuchstaben L / only valid with 4th letter L					